

УДК 539.143.43

© 1991

ЭФФЕКТЫ УСИЛЕНИЯ ЯМР И МАГНИТОУПРУГОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В МАГНЕТИКАХ

Э. П. Суладзе, К. О. Хуцишвили

Исследуются эффекты усиления ЯМР с учетом магнитоупругой подсистемы. Получены выражения для коэффициента усиления ЯМР в ферро- и антиферромагнетиках. Показано, что в случае близости одной из мод свободных магнитоупругих колебаний и частоты ЯМР влияние упругой подсистемы приводит к заметному увеличению сигнала ЯМР.

В работе [1] при исследовании динамических свойств ядерной подсистемы в магнитоупорядоченных материалах, в частности в FeVO_3 , наблюдалось значительное влияние упругой подсистемы на характеристики ядерного магнитного резонанса. Было высказано предположение, что в случае близости частот одной из мод свободных магнитоупругих колебаний и ядерного резонанса (при этом частота электронов находится гораздо больше) должно происходить увеличение наблюдаемого сигнала ЯМР.

Целью данной работы является исследование эффектов усиления в ферро- и антиферромагнетиках с учетом упругой подсистемы. Отметим, что в работе [2] был исследован случай, когда частота звука гораздо больше или меньше частоты ЯМР.

1. Рассмотрим сперва ферромагнетик кубической симметрии, намагниченный до насыщения вдоль одного из ребер куба, например $[001] \parallel z$. Предположим, что к системе приложено постоянное магнитное поле $H_0 \parallel z$ и линейно-поляризованное переменное магнитное поле h_x вдоль оси x . В частном случае магнитоупругих (МУ) волн, распространяющихся вдоль намагниченности (т. е. с волновым вектором $k \parallel z$), гамма-тонииан системы электронных и ядерных спинов можно задать в виде

$$\mathcal{H} = -H_0[M_x + m_x] + A(\nabla M)^2 + K[M_x^2 M_y^2 + M_x^2 M_z^2 + M_y^2 M_x^2] + A_0 m M + \\ + B \left(M_y \frac{\partial u_y}{\partial z} + M_x \frac{\partial u_x}{\partial z} \right) + \frac{C}{2} \left[\left(\frac{\partial u_y}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} \right)^2 \right] - h_x (M_x + m_x), \quad (1)$$

где A — коэффициент неоднородного обменного взаимодействия, K — перенормированная из-за магнитострикции константа анизотропии [3], B — компонента тензора магнитоупругих констант [3], A_0 — константа сверхтонкого взаимодействия, C — компонента тензора модуля упругости [3], m и M — ядерная и электронная намагниченности, u — вектор смещения.

Запишем уравнения движения для M , m и u

$$M = \gamma_e \left[M, \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta M} \right],$$

$$m = \gamma_n \left[m, \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta m} \right],$$

$$\rho \frac{d^2 u_i}{dt^2} = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u_{ij}} \frac{1 + \delta_{ij}}{2},$$

$$u_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right), \quad (2)$$

$\delta/\delta M$ — вариационная производная, γ_e , γ_n — гироманнитные отношения электронов и ядер, ρ — плотность образца, u_{ij} — тензор деформации, $\delta_{ij}=1$ или 0 соответственно при $i=j$ и $i \neq j$.

Следует оговорить, что в дальнейшем будем рассматривать образцы с толщиной d , в которых укладывается целое число полуволн (например, в случае, если граничные условия таковы, что на поверхности образца ядерные спины закреплены). При этом имеем $k=k_z = \pi P/d$, где $P=1, 3, 5, \dots$. В этих граничных условиях однородным радиочастотным полем можно возбудить поляризованные в плоскости образца стоячие магнитоупругие колебания, для которых суммарный магнитный момент отличен от нуля.

Используя (1) в (2) и линеаризируя полученные уравнения по поперечным (относительно равновесных направлений) составляющим векторов \mathbf{M} и \mathbf{m} , можно вычислить полную восприимчивость электронно-ядерной спин-системы в линейном приближении относительно внешнего переменного поля. Представим ее в виде

$$\chi_{xx}(\omega) = \chi_{MM} + 2\chi_{mM} + \chi_{mm}, \quad (3)$$

$$\chi_{MM} = \gamma_e M_0 \frac{(\omega^2 - \omega_i^2)(\omega - \omega_n)}{D},$$

$$\chi_{mM} = -\gamma_e \gamma_n A_0 M_0 m_0 \frac{\omega^2 - \omega_i^2}{D},$$

$$\chi_{mm} = \gamma_n m_0 \frac{(\omega^2 - \omega_i^2)(\omega - \omega_e) - \zeta^2 \omega_i^2 \omega_e}{D}, \quad (4)$$

$$D = (\omega^2 - \omega_i^2)(\omega - \omega_e)(\omega - \omega_n) - \omega_T^2(\omega^2 - \omega_i^2) - \zeta^2 \omega_i^2 \omega_e (\omega - \omega_n), \quad (5)$$

где M_0 и m_0 — равновесная электронная и ядерная намагниченности, ω_n — несмещенная частота ЯМР, ω_i — частота свободной звуковой волны, $\omega_e = \gamma_e (H_0 + H_a + H_{\text{му}}^0 + Ak^2)$ — несмещенная частота электронных спинов, H_a — поле анизотропии, H_n — сверхтонкое поле, $H_{\text{му}}^0$ — поле спонтанной магнитоупругости [3], $\omega_T^2 = \gamma_e \gamma_n A_0^2 M_0 m_0$ описывает «перепутывание» электронных и ядерных колебаний, ζ^2 — безразмерный параметр магнитоупругой связи [3].

Полагая $\omega_d \gg \omega_n$, ω_i , для восприимчивости вблизи частоты ЯМР имеем

$$\chi_{xx}(\omega) = \chi_{mm}(\Omega_n)(1 + \eta)^2, \quad (6)$$

$$\eta = \frac{\chi_{MM}(\Omega_n)}{\chi_{mM}(\Omega_n)} = \frac{\chi_{mM}(\Omega_n)}{\chi_{mm}(\Omega_n)},$$

$$\chi_{mm}(\Omega_n) = \frac{\gamma_n m_0}{\Omega_n - \omega} \frac{\Omega_i - \omega'_n}{\Omega_i - \Omega_n},$$

$$\Omega_e = \omega'_n - \omega_n \eta_A \eta_B \frac{m_0}{M_0}, \quad \Omega_i = \omega'_i + \omega_n \eta_A \eta_B \frac{m_0}{M_0}. \quad (7)$$

Здесь $\omega'_i = \omega_i [1 - \zeta^2 \omega_i / (\omega_i + \omega_n)]$, $\omega'_n = \omega_n (1 - \eta_B m_0 / M_0)$. Для определенности мы считаем, что $\omega_i > \omega_n$.

Величина η является коэффициентом усиления сигнала ЯМР. Она имеет вид

$$\eta = \eta_B (1 + \eta_A), \quad (8)$$

$$\eta_B = \frac{\gamma_e H_0}{\omega_e},$$

$$\eta_A = \frac{\zeta^2 \omega_i^2}{(\omega_i + \omega_n)(\omega_i - \omega_n^*)}$$

Легко видеть, что η_A в основном обусловлен влиянием электронной подсистемы на ядра. А η_A можно трактовать как коэффициент усиления, связанный с наличием упругой подсистемы. Как будет показано ниже, при определенных условиях η_A может внести весьма существенный вклад в усиление сигнала ЯМР. Используя выражения для Ω_i и ω_n' , нетрудно показать, что

$$\eta_A = \frac{2\xi}{1 + (1 + \sigma)^{1/2}}, \quad (9)$$

$$\sigma = 4\xi^2 \frac{\gamma_e}{\gamma_n} \frac{\omega_n^2 (\omega_i + \omega_n)}{\zeta^2 \omega_i^2 \omega_e} \frac{m_1}{M_0}, \quad \xi = \frac{\zeta^2 \omega_i^2}{(\omega_i + \omega_n)(\omega_i - \omega_n')}$$

где σ — параметр связанности ядерной и упругой подсистемы.

В случае слабой связанности ($\sigma \ll 1$), чему способствуют условие $\omega_i' \gg \omega_n'$ и относительно высокие температуры (отношение m_0/M_0 мало), из (9) имеем

$$\eta_A = \frac{\zeta^2 \omega_i}{(\omega_i + \omega_n) \left(1 - \zeta^2 \frac{\omega_i}{\omega_i + \omega_n}\right)}. \quad (10)$$

Как следует из (10), величина η_A зависит от параметра ζ^2 , который по величине меньше или равен единице [3]. Можно показать, что условие $\omega_i' \gg \omega_n'$ удовлетворяется при $\zeta^2 \ll 1$, т. е. в случае $\sigma \ll 1$ упругая подсистема почти не влияет на величину коэффициента усиления ЯМР. Отметим, что появление в выражении $\chi_{mn}(\Omega_n)$ коэффициента $(\Omega_i - \Omega_n)/(\Omega_i - \Omega_n)$ обусловлено наличием динамической связи между ядерной и упругой подсистемами. В случае $\sigma \ll 1$ этот коэффициент равен единице.

При $\sigma \gg 1$, чему способствуют условие $\omega_i' \sim \omega_n'$ и относительно низкие температуры, из (9) получим

$$\eta_A = \left[\frac{\gamma_n}{\gamma_e} \frac{\zeta^2 \omega_i^2 \omega_e}{\omega_n^2 (\omega_i + \omega_n)} \frac{M_0}{m_0} \right]^{1/2}$$

Для оценки величины η_A отметим, что условие $\omega_i' \sim \omega_n'$ удовлетворяется в двух случаях: 1) $\omega_i \gg \omega_n$, $\zeta^2 \ll 1$ или 2) $\omega_i \sim \omega_n$, $\zeta^2 \ll 1$. Полагая, что $\gamma_n/\gamma_e \sim 10^{-3}$, $M_0/m_0 \sim 10^6$, $\zeta^2 \omega_i \omega_e / \omega_n^2 \sim 10^2$ и $\zeta^2 \omega_i \omega_e / \omega_n^2 \sim 1$ для первого и второго случая соответственно имеем $\eta_A \sim 10^{2.5}$ и $\eta_A \sim 10^{2.5}$. Таким образом, при $\sigma \gg 1$ упругая подсистема заметно увеличивает коэффициент усиления ЯМР.

2. Рассмотрим теперь одноосный двухподрешеточный антиферромагнетик типа «легкая плоскость». Пусть ось z является главной осью симметрии кристалла, вдоль оси x направлен равновесный вектор антиферромагнетизма, вдоль оси y — постоянное магнитное поле H_0 . Переменное магнитное поле приложено вдоль оси x . Гамильтониан такой системы можно задать в виде [3]

$$\begin{aligned} \mathcal{H} = & -H_0(M_{1y} + M_{2y} + m_{1y} + m_{2y}) + A(\nabla M_1)^2 + A(\nabla M_2)^2 - A\nabla M_1 \nabla M_2 + \\ & + K[M_{1x}^2 + M_{2x}^2] + \frac{1}{2} J_0 M_1 M_2 + A_0 m_1 M_1 + A_0 m_2 M_2 + \\ & + \sum_{ijnl} B_{ijnl} (M_{1j} M_{1i} + M_{2j} M_{2i}) u_{nl} + \frac{1}{2} \sum C_{ijnl} u_{ij} u_{nl} - \\ & - h_x (M_{1x} + M_{2x} + m_{1x} + m_{2x}); \quad i, j, n, l = x, y, z, \end{aligned} \quad (11)$$

где M_1 , M_2 , m_1 , m_2 — электронные и ядерные моменты намагниченности подрешеток; J_0 — константа однородного обмена.

Рассмотрим частный случай магнитоупругих волн, распространяющихся вдоль оси y ($\mathbf{k} \parallel \mathbf{H}_0$) и поляризованных в «легкой плоскости».

Используя явный вид тензоров B_{ijnl} , C_{ijnl} [3], с помощью (2) и (11) можно получить связанные уравнения движения для M_1 , M_2 , m_1 , m_2 и u_{ij} . Решая эти уравнения в линейном приближении по малым колебаниям, вблизи основного состояния ($M_{1,2}^{(0)}$, $m_{1,2}^{(0)}$, $u_{i,j}^{(0)}$), для полной восприимчивости электронно-ядерной системы имеем формулу (3), где теперь

$$\chi_{MM} = \gamma_e 2M_0 M_{y0} \omega_{e0} \frac{(\omega^2 - \omega_i^2)(\omega^2 - \omega_n^2)}{D},$$

$$\chi_{mM} = -2\gamma_n M_0 M_{y0} \omega_{n0} \omega_T^2 \frac{\omega^2 - \omega_i^2}{D},$$

$$\chi_{mm} = \gamma_n 2m_0 m_{y0} \omega_{n0} \frac{(\omega^2 - \omega_i^2)(\omega^2 - \omega_e^2 - \omega_T^2) - \zeta^2 \omega_i^2 \omega_e^2}{D},$$

$$D = (\omega^2 - \omega_i^2) [(\omega^2 - \omega_e^2)(\omega^2 - \omega_n^2) - \omega_T^2 \omega^2] - \zeta^2 \omega_i^2 \omega_e^2 (\omega^2 - \omega_n^2),$$

где $\omega_e^2 = \gamma_e^2 (H_0^2 + H_E H_{\text{мг}} + Ak^2 H_E)$, $\omega_T^2 = \gamma_e^2 H_E A_0 m_0$, $\omega_{n0} = \gamma_n (H_0 + H_n \sin \varphi)$, H_E — обменное поле, $H_{\text{мг}}$ — магнитоупругое поле, $\omega_{e0} = \gamma_e H_0$, $m_{y0} = 2m_0 \sin \psi$, $M_{y0} = 2M_0 \sin \varphi$, $\varphi = H_0/H_E$ и $\psi = H_0/H_E + H_0/H_n$ являются углами отклонений равновесных электронных и ядерных намагниченностей от оси x [4].

Полагая $\omega_e \gg \omega_n$, ω_i , для восприимчивости вблизи частот ЯМР имеем формулы (6)–(9), где

$$\chi_{mm}(\Omega_n) = \frac{\gamma_n m_{y0} \omega_{n0}}{\Omega_n^2 - \omega^2} \frac{\Omega_i^2 - \omega_n'^2}{\Omega_i^2 - \Omega_n^2},$$

$$\eta_3 = \frac{H_n}{H_E + H_n} \frac{\gamma_e^2 H_E H_n}{\omega_e^2 + \omega_T^2},$$

$$\sigma = 4\zeta^2 \frac{\omega_n^2 \gamma_e^2 H_E H_n}{\omega_e^2 \omega_i^2} \frac{m_n}{M_0},$$

$$\bar{\sigma} = \frac{\zeta^2 \omega_i^2}{\omega_i'^2 - \omega_n^2},$$

$$\Omega_n^2 = \omega_n'^2 - \omega_n^2 \eta_A \eta_3 \frac{M_{y0}}{M_{y0}'},$$

$$\Omega_i^2 = \frac{\omega_e^2 \omega_i'^2}{\omega_e^2 + \omega_T^2} + \omega_n^2 \eta_A \eta_3 \frac{m_{y0}}{M_{y0}'},$$

Здесь

$$\omega_n'^2 = \omega_n^2 (1 - \eta_3 m_{y0}/M_{y0}'), \quad \omega_i'^2 = \omega_i^2 - \zeta^2 \omega_e^2 + \omega_T^2 \omega_i^2 / \omega_e^2.$$

При $\omega_i'^2 \gg \omega_n^2$ и высоких температурах ($\omega_e^2 \gg \omega_T^2$) имеем

$$\eta = \frac{\zeta^2}{1 - \zeta^2}.$$

Так как при этом $\zeta^2 \ll 1$, то при слабой связанности ($\sigma \ll 1$) упругая подсистема не влияет на коэффициент усиления ЯМР. Следует указать на одно обстоятельство. Мы определяем η единым образом (как для ферромагнетиков, так и антиферромагнетиков) как отношение (7), а в [2] квадрат коэффициента усиления определяется как отношение $\chi_{mm}(\Omega_n)/\chi_{mm}^d$. [$\chi_{mm}^d = \gamma_n m_0 \Omega_n / (\Omega_n^2 - \omega^2)$ — восприимчивость ядерной спин-системы в диамагнитном кристалле]. Естественно, что при таком способе определения в случае $\sigma \ll 1$ мм получили бы результат работы [2].

В случае $\sigma \gg 1$ получим

$$\eta_A = \left[\frac{\omega_e^2 \omega_i^2}{\omega_n^2 \gamma_e^2 H_E H_n} \frac{M_0}{m_0} \right]^{1/2}.$$

Для оценки $\eta_{i,1}$, как и для ферромагнетика, следует рассмотреть два случая: 1) $\omega_i^2 \gg \omega_n^2$, $\zeta^2 \ll 1$; 2) $\omega_i^2 \sim \omega_n^2$, $\zeta^2 \ll 1$. Полагая, что $H_0 \sim 10^2$ Э, $H_E \sim 10^6$ Э, $H_n \sim 10^5$ Э, $H_{\text{мг}} \sim 1$ Э, $M_0/m_0 \sim 10^6$, $\zeta^2 \omega_i^2/\omega_n^2 \sim 10^2$ и $\zeta^2 \omega_i^2/\omega_n^2 \sim 1$ для первого и второго случая соответственно имеем $\eta_{i,1} \sim 10^{3/2}$ и $\eta_{i,1} \sim 10^{1/2}$.

Отметим, что в работе [1] при совпадении частот ω'_i и ω_n наблюдалось значительное усиление сигнала ядерной индукции.

В конце отметим, что учет затухания как в упругой, так и в ядерной подсистеме может являться существенным для эффекта усиления ЯМР. Рассмотрим для простоты случай ферромагнетика. Приравнивая к нулю выражение (5), можно найти сдвинутые частоты связанных ядерно-акустических колебаний. Далее, заменяя $\omega_n \rightarrow \omega_n + i\Gamma_n$ и $\omega_i \rightarrow \omega_i + i\Gamma_i$, где Γ_i и Γ_n — параметры затухания для акустической и ядерной подсистемы, и полагая, что $\Gamma_i \gg \Gamma_n$, $\omega_i^2 \zeta^2 \omega_i^2/\omega_n^2$ ($\omega_i + \omega_n$) при $\omega'_i \sim \omega'_n$, для коэффициента усиления получим формулу, аналогичную приведенной в работе [5]

$$\eta = A_0 |\chi|, \quad (12)$$

$$\chi = \frac{\gamma_e M_0}{\omega_e} \left[1 + \frac{\zeta^2 \omega_i^2}{(\omega_i + \omega_n)(\omega'_i - \omega'_n + i\Gamma_i)} \right].$$

Таким образом, как следует из (12), затухание может привести к изменению величины коэффициента усиления ЯМР. Очевидно, что для расчета более сложных случаев (при любом соотношении вышеуказанных параметров) можно воспользоваться аналогичными выкладками.

Авторы выражают благодарность Л. Л. Буишвили за внимание к работе и И. В. Плешакову за стимулирующие дискуссии.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Петров М. П., Иванов А. В., Паугурт А. П., Плешаков И. В. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 6. С. 1819—1825.
- [2] Тарасенко С. В., Телена В. Т., Чепурных Г. К. // ФТТ. 1984. Т. 26. № 2. С. 560—562.
- [3] Туров Е. А., Шавров В. Г. // УФН. 1983. Т. 140. № 3. С. 429—462.
- [4] Туров Е. А., Петров М. П. // Ядерный магнитный резонанс в ферро- и антиферромагнетиках. М., 1969. 260 с.
- [5] Цифринович В. И., Игнатченко В. А. // ЖЭТФ. 1977. Т. 72. № 2. С. 803—807.

Тбилисский
государственный университет

Поступило в Редакцию
14 ноября 1990 г.
В окончательной редакции
23 апреля 1991 г.